

2SC1346, 2SC1347

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ型 / Si NPN Epitaxial Planar

低周波出力増幅用 / AF Output Amplifier

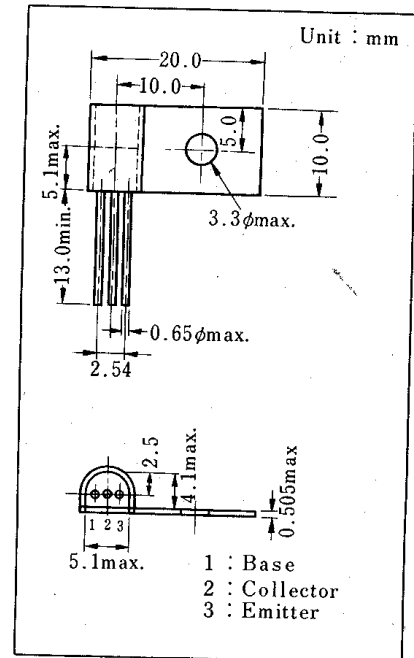
2SA730, 2SA731 とコンプリメンタリ / Complementary Pair
with 2SA730, 2SA731

特 徴 / Features

- コレクタ・エミッタ飽和電圧が低い。 / Low $V_{CE(sat)}$
- 2SA730, 2SA731 とコンプリメンタリペアで出力 1W が得られます。 /
1 W output in complementary pair with 2SA730, 2SA731.

最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
		60	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	25	V
		50	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CM}	1	A
コレクタ電流	I_C	500	mA
コレクタ損失 放熱板付(No. 37)	P_C	600	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	30			V
			60			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=10\text{mA}, I_B=0$	25			V
			50			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5			V
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$			0.1	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=150\text{mA}$	60	160	340	
	h_{FE2}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=500\text{mA}$	40	90		
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$		0.35	0.6	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$		1.1	1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB}=10\text{V}, -I_E=50\text{mA}$		200		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$		6	15	pF

詳細は 318 頁 (2SC1317, 2SC1318, 2SC1346, 2SC1347) をご参照ください。

Details refer to page 318 (2SC1317, 2SC1318, 2SC1346, 2SC1347).